Лабораторна робота 1. Дослідження діода та стабілітрона Частина 1. Побудова ВАХ діода та стабілітрона.





1. Побудувати схему на рис. 1 у Multisim. Мультиметр XMM1 налаштувати як $U_{_{джерела}}$, В $U_{_{\pi}}$, В $I_{_{\pi}}$, А амперметр, а мультиметр XMM2 – як вольтметр. Діод взяти з вкладки «Place diode» — «DIODES_VIRTUAL» — «DIODE». Заповнити таблицю для значень напруги

джерела $U_{_{джерела}}$ рівних –10В; –9В; –8В; –7В; –6В; –5В; –4В; –3В; –2В; –1В; 0В; 0,1В; 0,2В; 0,3В; 0,4В; 0,5В; 0,6В; 0,7В; 0,8В; 0,9В; 1В; 2В; 3В; 4В; 5В; 6В; 7В; 8В; 9В; 10В; $U_{_{\pi}}$ – напруга на діоді, виміряна мультиметром XMM2, $I_{_{\pi}}$ – струм через діод, виміряний мультиметром XMM1. *На основі отриманих даних побудувати в Ехсеl два графіки: ВАХ діода для всіх виміряних точок та ВАХ діода в області додатних* (прямих) напруг на діоді. Оцінити статичний та диференційний опори діода при значенні напруги 0,7В. Статичний опір діода визначається формулою $R = U_{_{\pi}}/I_{_{\pi}}$, диференційний опір діода визначається виразом $R_{_{диф}} = \frac{dU_{_{\pi}}}{dI_{_{\pi}}} = \frac{1}{dI_{_{\pi}}/dU_{_{\pi}}}$, де $dI_{_{\pi}}/dU_{_{\pi}}$

похідна від функції $I_{_{\mathcal{I}}}(U_{_{\mathcal{I}}})$.

2. Замінити в схемі діод стабілітроном, тобто зібрати схему на рис. 2.



Рис. 2

Стаблітітрон взяти з вкладки «Place diode» \rightarrow «DIODES_VIRTUAL» \rightarrow «ZENER». $U_{\text{джерела}}$, В U_{c} , В I_{c} , А Встановити напругу стабілізації стабілітрона («Breakdown voltage») рівною 9В. Заповнити таблицю для значень напруги джерела $U_{_{джерела}}$ рівних –15В; –14В; –13В; –12В; –11В; –10В; – 9,9В; –9,8В; –9,7В; –9,6В; –9,5В; –9,4В; –9,3В; –9,2В; –9,1В; –9В; –8,9В; –8,8В; –8,7В; –8В; –7В; –6В; –5В; –4В; –3В; –2В; –1В; 0В; 0,1В; 0,2В; 0,3В; 0,4В; 0,5В; 0,6В; 0,7В; 0,8В; 0,9В; 1В; 2В; 3В; 4В; 5В; 6В; 7В; 8В; 9В; 10В; U_c – напруга на стабілітроні, виміряна мультиметром XMM2, I_c – струм через стабілітрон, виміряний мультиметром XMM1. *На основі отриманих даних побудувати в Ехсеl два графіки: ВАХ стабілітрона для всіх виміряних точок та ВАХ стабілітрона для напруг джерела від –15В до –8В. Оцінити статичний та диференційний опори стабілітрона при значенні напруги –8,95В.* Статичний опір стабілітрона визначається формулою $R = U_c/I_c$, диференційний опір діода визначається виразом

$$R_{\rm диф} = \frac{dU_{\rm c}}{dI_{\rm c}} = \frac{1}{dI_{\rm c}/dU_{\rm c}}, \text{ де } dI_{\rm c}/dU_{\rm c} - \text{похідна від функції } I_{\rm c}(U_{\rm c}).$$

Примітка: в стабілітрон в пакеті Multisim «вбудоване» характерне значення прямої напруги, при якій починає проходити струм, не 0,7В, а 0,6В.





1. Зібрати схему як на рис. З. *Зробити скріншоти осцилограм* та пояснити отримані осцилограми. *Впродовж одного періоду* побудувати на комп'ютері в будьякому математичному пакеті або програмному середовищі теоретичні залежності:

$$U_{R}(t) = \begin{cases} E\sin(\omega t) - U_{0,7}, \omega t \in [\alpha + 2\pi n; \pi - \alpha + 2\pi n], n \in \mathbb{Z} \\ 0, \text{ інакше} \end{cases}; \ \alpha = \arcsin\left(\frac{U_{0,7}}{E}\right); \ E = 10\sqrt{2}\text{B}; \\ U_{D}(t) = \begin{cases} U_{0,7}, \omega t \in [\alpha + 2\pi n; \pi - \alpha + 2\pi n], n \in \mathbb{Z} \\ E\sin(\omega t), \text{ інакшe} \end{cases}; \ U_{\text{\tiny BX}}(t) = E\sin(\omega t); \ U_{0,7} = 0, 7\text{B}. \end{cases}$$

Побудувати треба два теоретичних графіки – на одному $U_{\text{вх}}(t)$ та $U_{D}(t)$, на іншому – $U_{\text{вх}}(t)$ та $U_{R}(t)$), $U_{\text{вх}}(t)$ – амплітуда на клемах генератора синусоїди, $U_{D}(t)$ – напруга на діоді, $U_{R}(t)$ – напруга на резисторі.



2. Зібрати схему як на рис. 4. *Зробити скріншоти осцилограм* та пояснити отримані осцилограми. *Впродовж одного періоду* побудувати на комп'ютері в будьякому математичному пакеті або програмному середовищі теоретичні залежності:

$$\tilde{U}_{S}(t) = \begin{cases} -U_{0,7}, \omega t \in (\pi + \beta + 2\pi n; 2\pi - \beta + 2\pi n) \\ U_{cT}, \omega t \in (\alpha + 2\pi n; \pi - \alpha + 2\pi n) \\ E \sin(\omega t), \text{iHakule} \end{cases}, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad \alpha = \arcsin(U_{cT}/E); \\ E \sin(\omega t), \text{iHakule} \end{cases}$$

$$U_{R}(t) = \begin{cases} E \sin(\omega t) + U_{0,7}, \omega t \in (\pi + \beta + 2\pi n; 2\pi - \beta + 2\pi n) \\ E \sin(\omega t) - U_{cT}, \omega t \in (\alpha + 2\pi n; \pi - \alpha + 2\pi n) \\ 0, \text{iHakule} \end{cases}, \quad n \in \mathbb{Z}; \quad \beta = \arcsin(U_{0,7}/E);$$

 $E = 10\sqrt{2}B; U_{BX}(t) = E\sin(\omega t); U_{0,7} = 0,7B; U_{CT} = 10B.$

Побудувати треба два теоретичних графіки – на одному $U_{\text{вх}}(t)$ та $\tilde{U}_{S}(t)$, на іншому – $U_{\text{вх}}(t)$ та $U_{R}(t)$), $U_{\text{вх}}(t)$ – амплітуда на клемах генератора синусоїди, $\tilde{U}_{S}(t)$ – напруга <u>«проти стрілки»</u> на стабілітроні, $U_{R}(t)$ – напруга на резисторі.

3. На схемі на рис. 4. змінити діяльне значення синусоїдальної напруги з 10В на 5В. *Зробити скріншоти осцилограм* та пояснити отримані осцилограми. *Впродовж одного періоду* побудувати на комп'ютері в будь-якому математичному пакеті або програмному середовищі теоретичні залежності:

$$\begin{split} \tilde{U}_{S}(t) &= \begin{cases} -U_{0,7}, \omega t \in (\pi + \beta + 2\pi n; 2\pi - \beta + 2\pi n) \\ E \sin(\omega t), \text{inakule} \end{cases}, \ n \in \mathbb{Z}; \ U_{\text{\tiny BX}}(t) &= E \sin(\omega t); \\ U_{R}(t) &= \begin{cases} E \sin(\omega t) + U_{0,7}, \omega t \in (\pi + \beta + 2\pi n; 2\pi - \beta + 2\pi n) \\ 0, \text{inakule} \end{cases}, \ n \in \mathbb{Z}; \ \beta &= \arcsin(U_{0,7}/E); \\ E &= 5\sqrt{2}B; \ U_{0,7} &= 0, 7B; \ U_{\text{\tiny CT}} &= 10B. \end{split}$$

Побудувати треба два теоретичних графіки – на одному $U_{\text{вх}}(t)$ та $\tilde{U}_{S}(t)$, на іншому – $U_{\text{вх}}(t)$ та $U_{R}(t)$), $U_{\text{вх}}(t)$ – амплітуда на клемах генератора синусоїди, $\tilde{U}_{S}(t)$ – напруга <u>«проти стрілки»</u> на стабілітроні, $U_{R}(t)$ – напруга на резисторі.

В усіх трьох випадках порівняти отримані осцилограми з теоретичними графіками, зробити висновок чи співпала теорія з «експериментом».

Важливо: в другій частині виставити максимальний крок моделювання у Multisim рівний 10^{-5} с. Для цього в меню «Simulate» — «Analyses and Simulation» — «Interactive Simulation» — «Maximum time step (TMAX)» відповідне значення виставити рівним 1е–005